

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成17年11月10日(2005.11.10)

【公表番号】特表2001-526836(P2001-526836A)

【公表日】平成13年12月18日(2001.12.18)

【出願番号】特願平10-542782

【国際特許分類第7版】

H 0 1 L 21/304

B 0 8 B 3/08

C 1 1 D 7/26

C 1 1 D 7/32

C 1 1 D 7/50

G 0 3 F 7/42

H 0 1 L 21/308

【F I】

H 0 1 L 21/304 6 4 7 A

B 0 8 B 3/08 Z

C 1 1 D 7/26

C 1 1 D 7/32

C 1 1 D 7/50

G 0 3 F 7/42

H 0 1 L 21/308 E

【手続補正書】

【提出日】平成17年3月15日(2005.3.15)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】補正の内容のとおり

【補正方法】変更

【補正の内容】

手続補正書

平成17年3月15日

特許庁長官殿

1 事件の表示 平成10年特許願542782号

2. 補正をする者

名称 イーケーシー テクノロジー, インコーポレイティド

3. 代理人

住所 〒104-0028

東京都中央区八重洲2丁目8番地7号 福岡ビル9階
阿部・井窪・片山法律事務所

電話 03-3273-2611

氏名 (9367) 弁理士 小林 純子



4. 補正対象書類名

請求の範囲

5. 補正対象項目名

請求の範囲

6. 補正の内容

別紙の通り



(別紙)

請 求 の 範 囲

1. 1～50重量%の少なくとも1種のエチレンジアミン四酢酸またはその一、二、三もしくは四アンモニウム塩、25～75重量%のアミンまたはアルカノールアミン、水またはジメチルスルホキシド、エチレングリコール、エチレングリコールアルキルエーテル、ジエチレングリコールアルキルエーテル、トリエチレングリコールアルキルエーテル、プロピレングリコール、プロピレングリコールアルキルエーテル、N-置換ピロリドン、スルホラ
ンおよびジメチルアセトアミドから選ばれる極性有機溶媒を含んでなる、フォトレジスト
または他の高分子材料または残渣をチタンを含む基板から除去するための組成物。
2. 0.15～10重量%の有機または無機のアモニウム塩をさらに含んでなる、請求項1
に記載の組成物。
3. 当該アンモニウム塩がアンモニアおよびエチレンジアミン四酢酸から当該組成物中
で形成される、請求項1に記載の組成物。
4. 5～25重量%のさらなるキレート剤をさらに含んでなる、請求項1に記載の組成物。
5. 当該キレート剤がカテコールまたは没食子酸である、請求項4に記載の組成物。
6. 当該組成物がヒドロキシルアミンを含まない組成物である、請求項1に記載の組
成物。
7. フォトレジスト、他の高分子材料または残渣を基板から除去するのに十分な時間お
よび温度で、少なくとも1種のエチレンジアミン四酢酸またはその一、二、三もしくは四
アンモニウム塩およびアミンまたはアルカノールアミンを含んでなる組成物と基板とを接
触させることを含む、フォトレジストまたは他の高分子材料または残渣をチタンを含む基
板から除去するための方法。
8. 当該時間が2～60分であり、当該温度が20～110℃である、請求項7に記載の方法。
9. 有機または無機のアモニウム塩と基板とを同時に接触させることをさらに含む、
請求項7に記載の方法。
10. 当該アンモニウム塩がエチレンジアミン四酢酸およびアンモニアから形成される、
請求項7に記載の方法。
11. さらなるキレート剤と基板とを同時に接触させることをさらに含む、請求項7に
記載の方法。
12. 当該キレート剤がカテコールまたは没食子酸である、請求項11に記載の方法。
13. 当該基板が集積回路のチタン層を含んでなる、請求項7に記載の方法。
14. 当該組成物がヒドロキシルアミンを含まない組成物である、請求項7に記載の
方法。